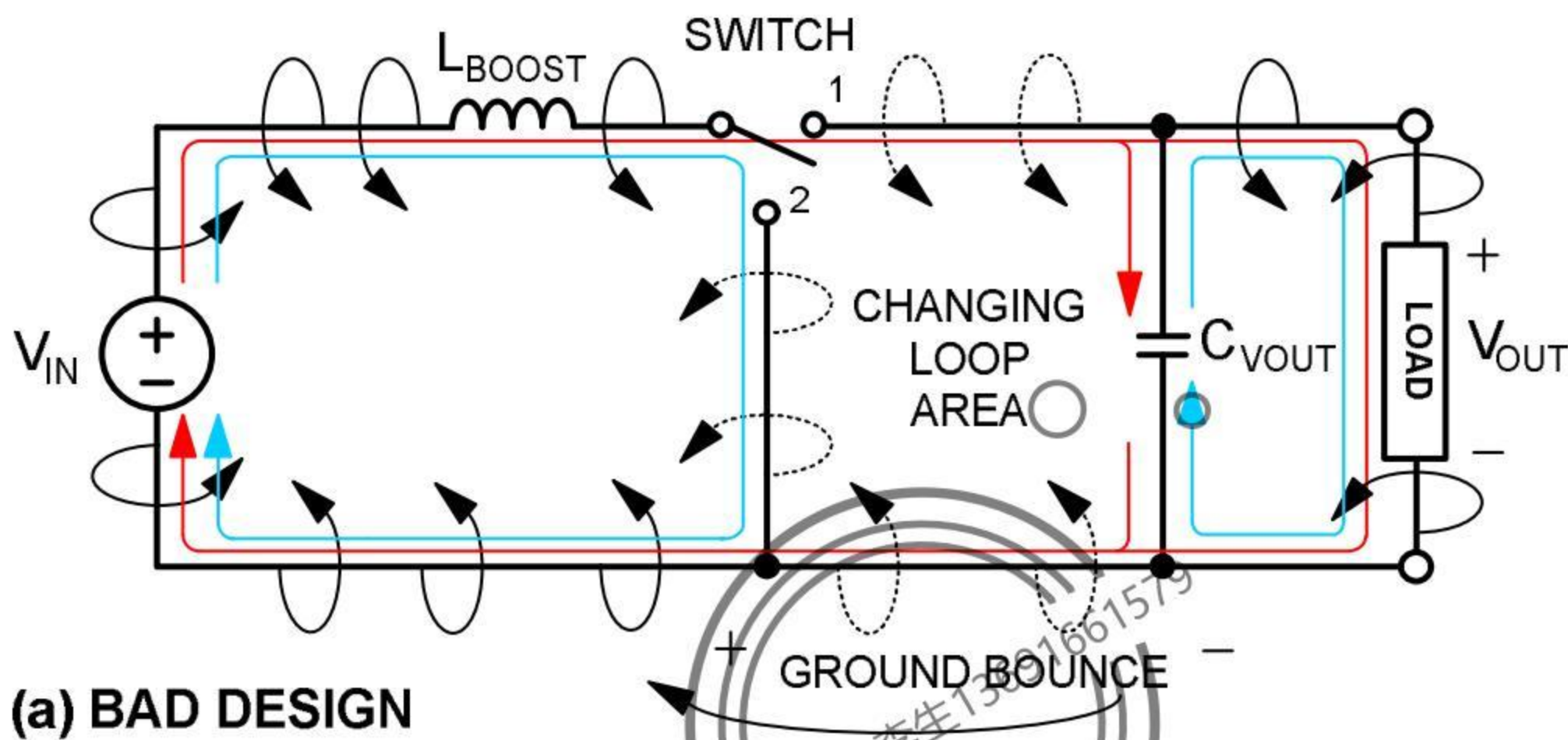
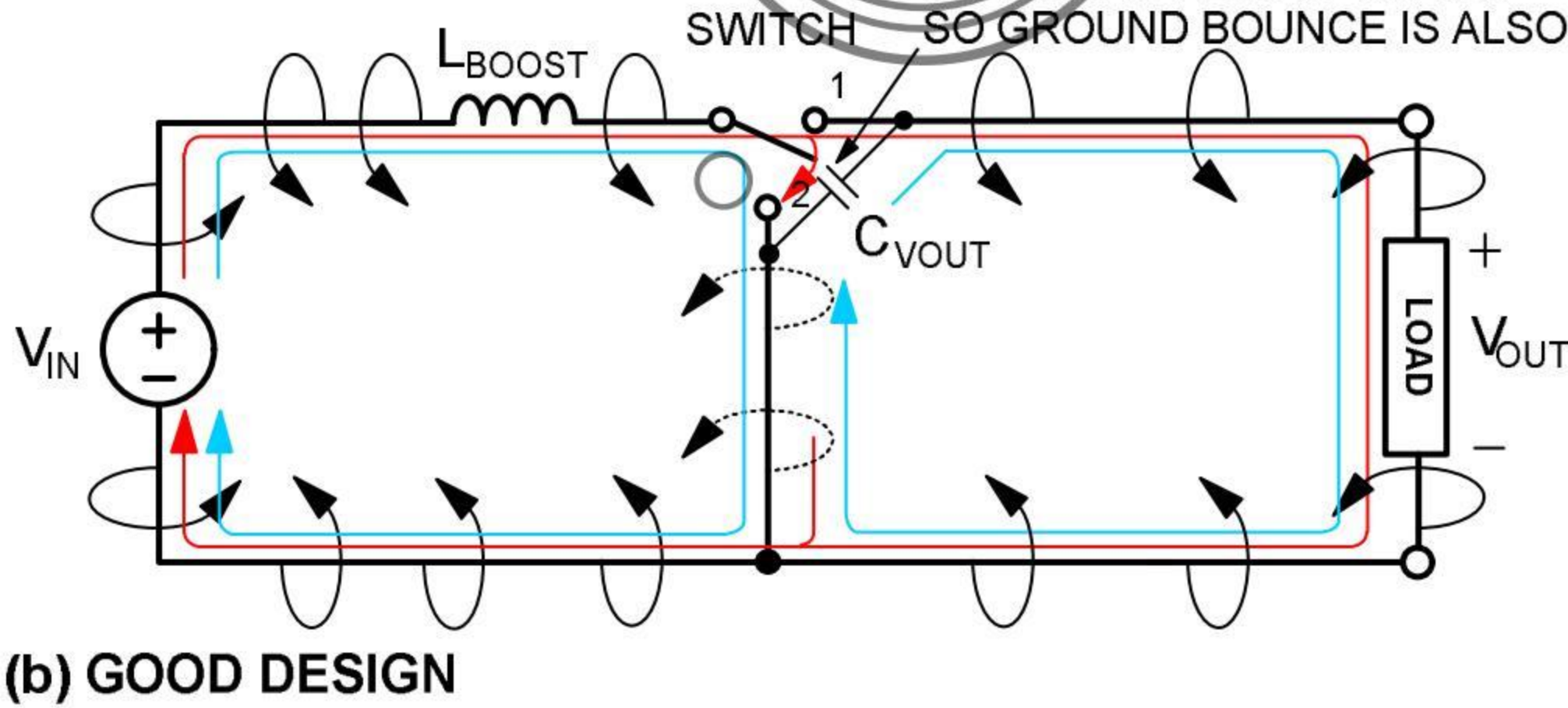


註一、 IC 在昇壓時輸出電容(C3/C4)會一直有充放電的動作，在 VO – C3&C4 – PGND 會產生一個電流迴路，這地方會產生快速的磁通量變化，而磁通量 \propto 電流迴路面積，在 PCB 板上的磁通量變化會產生與磁通量呈正比的突波電壓，所以盡可能減少電流迴路面積，降低在 PCB 板產生的磁通量，可有效抑制 EMI 輻射。

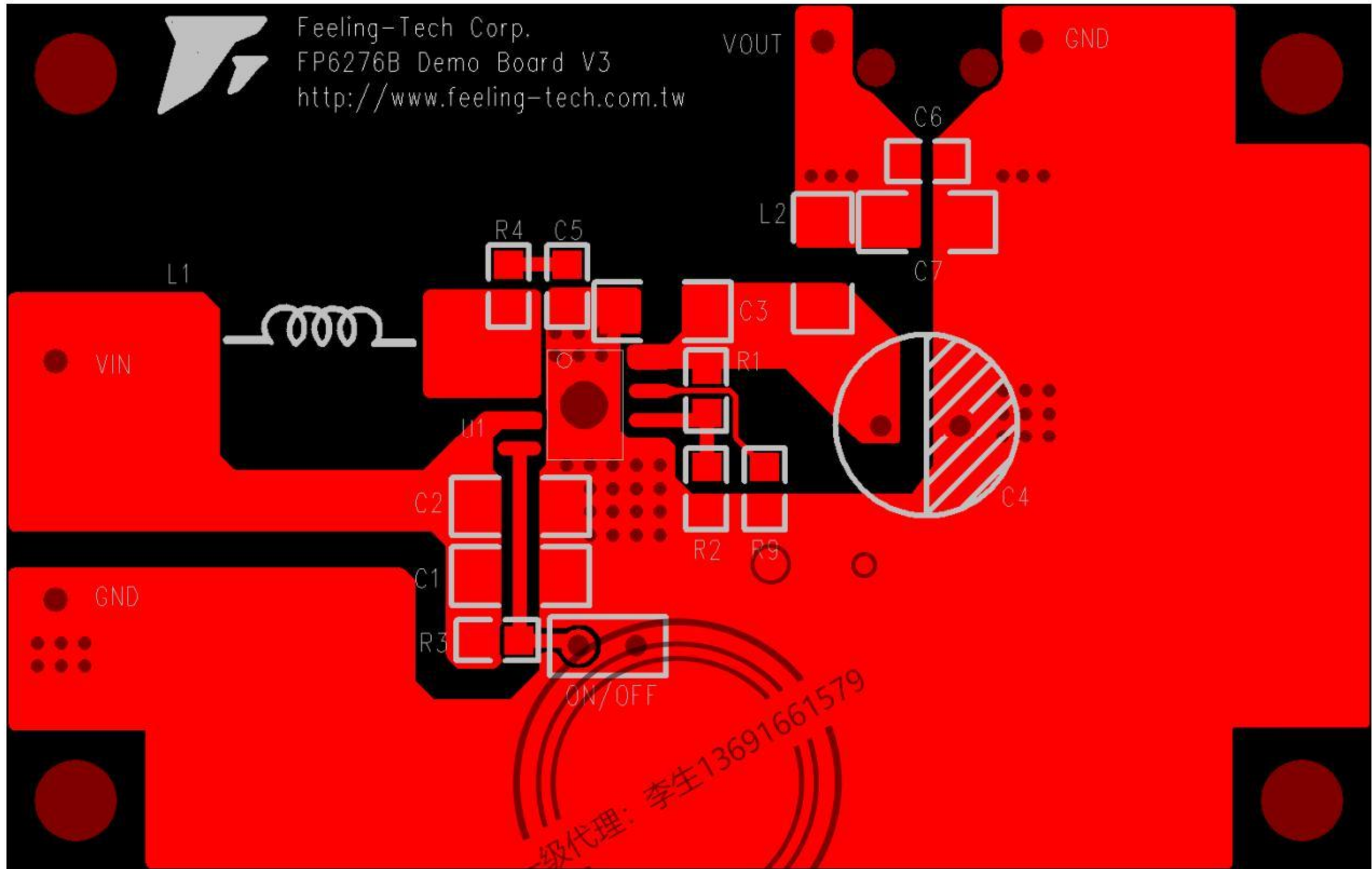


CHANGE IN LOOP AREA IS SMALL SO CHANGE IN FLUX IS SMALL, SO GROUND BOUNCE IS ALSO SMALL.

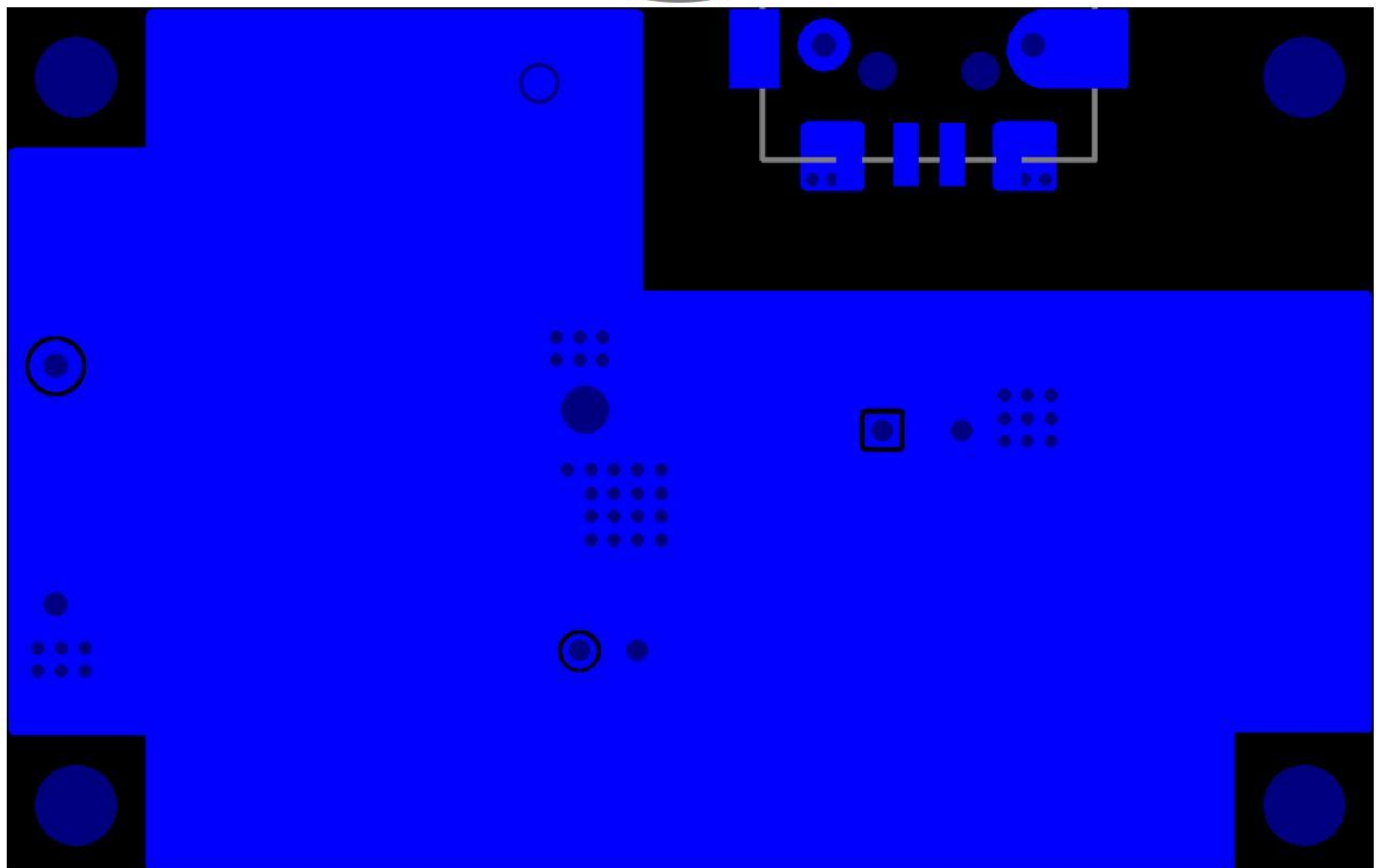


 遠翔科技 Feeling Technology	文件名稱	日期	
	FP6276B Layout Guide 與 EMI 對策		20170217
	版別		

TOP

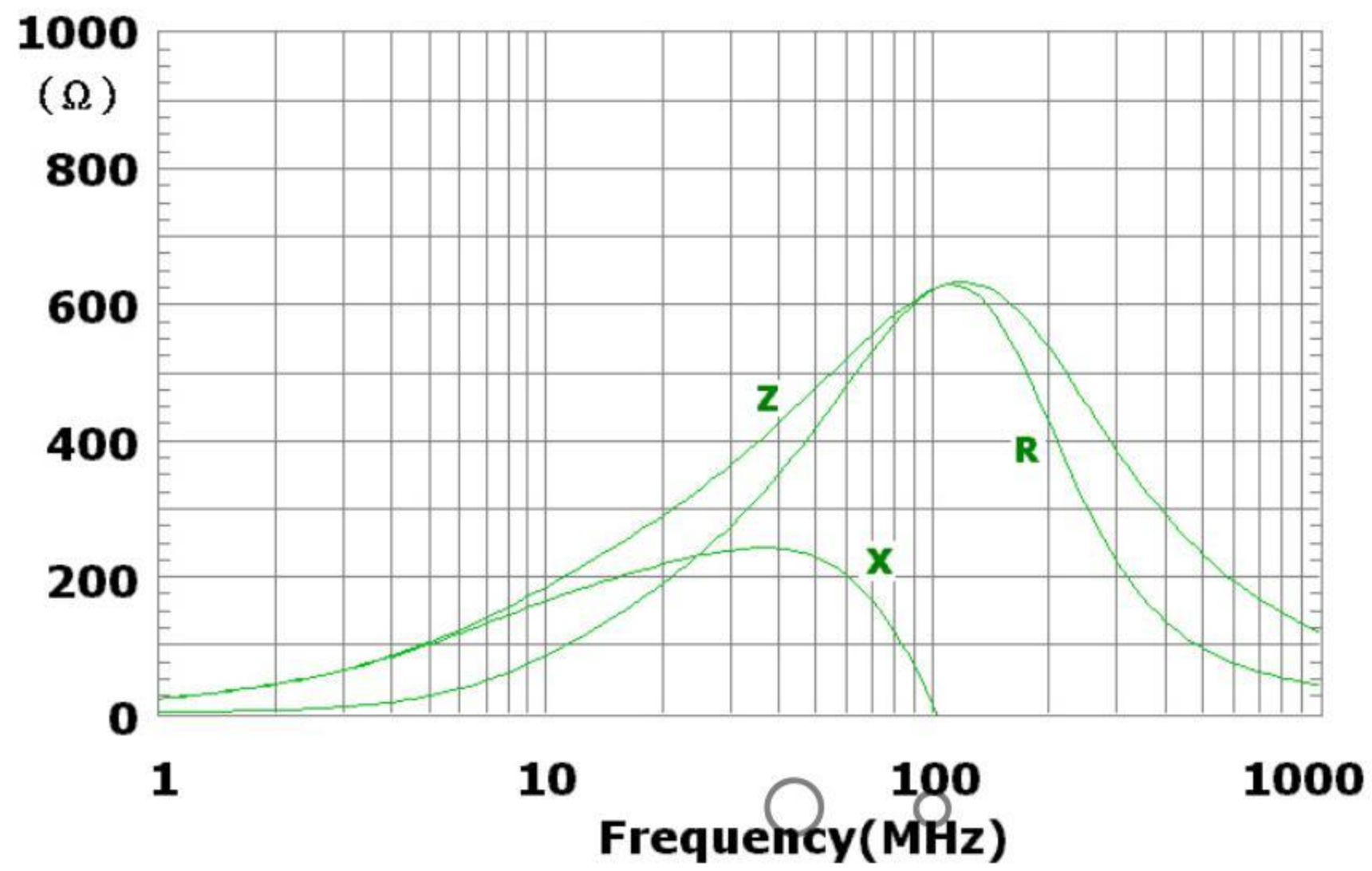


BOTTOM



	文件名稱	日期
	FP6276B Layout Guide 與 EMI 對策	20170217
		版別

挑選 BEAD 數值參考如下圖：



說明：建議挑選阻抗對頻率關係峰值落在 100MHz~200MHz 中間，峰值阻抗越大抑制效果越好。

